

NPN中等功率晶体管

特征

- 高电流
- 饱和电压低
- 补充2SB772

应用

- 电压调节
- 继电器驱动器
- 通用开关
- 音频功率放大器
- DC-DC转换器

描述

该器件是由NPN晶体管制造的
使用平面技术导致高强度
性能设备.互补的PNP
类型是2SB772.

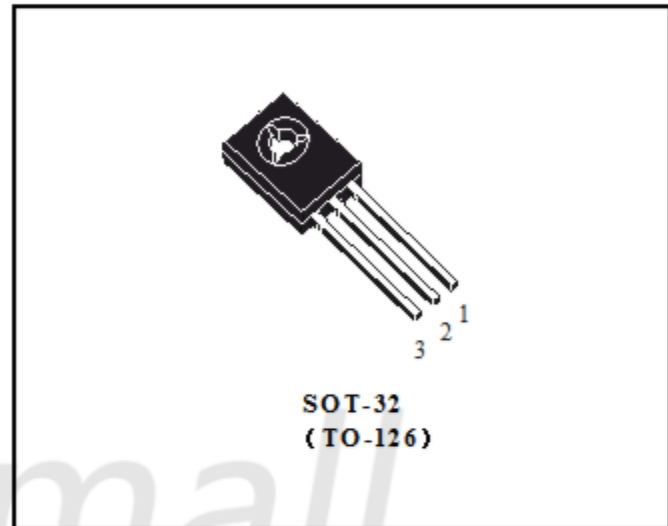
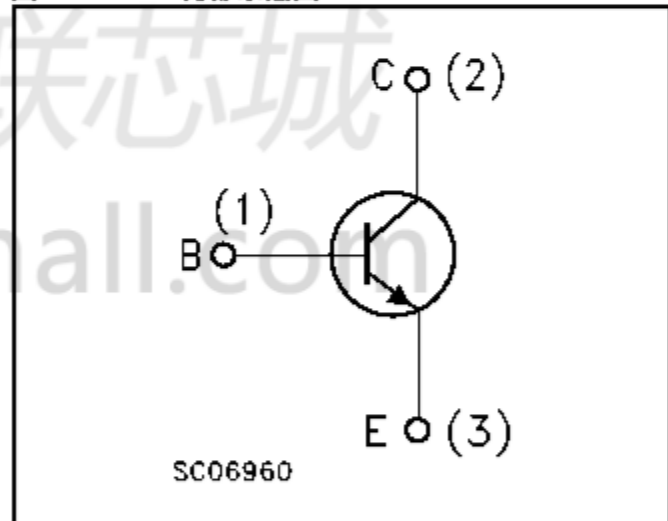


图1. 内部示意图



表格1. 设备摘要

订单代码	印记	包	填料
2SD882	D882	SOT-32	管

1 绝对最大额定值

表2 绝对最大额定值

符号	参数	值	单元
V CBO	集电极基极电压 (I E = 0)	60	V
V CEO	集电极发射极电压 (I B = 0)	三十	V
V EBO	集电极基极电压 (I C = 0)	五	V
我 C	收藏家目前	3	一个
我 CM	集电极峰值电流 (t P < 5ms)	6	一个
我 B	基本电流	1	一个
我是 B	基峰电流 (t P < 5ms)	2	一个
P TOT	T c = 25°C时的总功耗	12.5	w ^
T STG	储存温度	-65至150	C
T J	最大工作结温	150	C

表3. 热数据

符号	参数	值	单元
R thJ-case	热阻 结壳 最大	10	°C / W



2 电气特性

(T CASE = 25°C,除非另有说明)

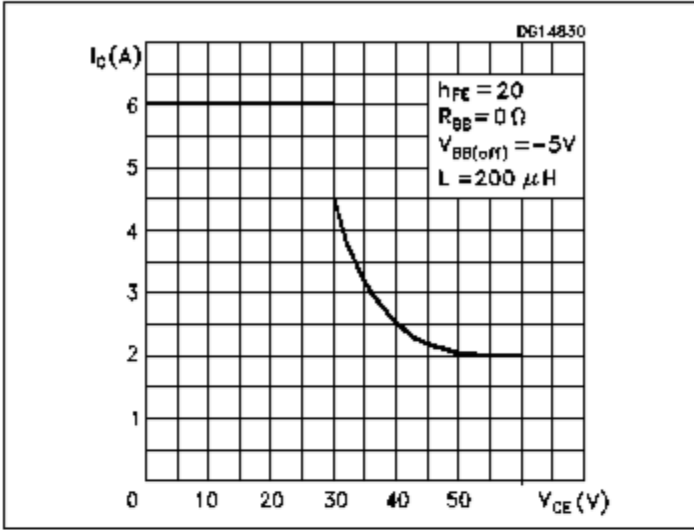
表4 电气特性

符号	参数	测试条件	负.	典型.	最大.	单元
我 CES	收集器截止电流 (V BE = 0)	V CE = 60V			10	μA
我是 CEO	收集器截止电流 (I B = 0)	V CE = 30V			100	μA
我是 EBO	发射极截止电流 (I C = 0)	V EB = 5V			10	μA
V (BR) CEO (1)	集电极发射极击穿 电压 (I B = 0)	I C = 10 mA	三十			V
V (BR) CBO	收集器基础故障 电压 (I E = 0)	I C = 100μA	60			V
V (BR) EBO	发射极击穿 电压 (I C = 0)	I E = 100μA	五			V
V CE (sat) (1)	集电极发射极饱和 电压	我 C = 1 A. I B = 50 mA 我 C = 2 A. I B = 100 mA 我 C = 3 A. I B = 150 mA			0.4 0.7 1.1	V V V
V BE (sat) (1)	基极发射极饱和 电压	我 C = 2 A. I B = 100 mA			1.2	V
h FE	直流电流增益	I C = 100 mA V CE = 2V 我 C = 1 A. V CE = 2V 我 C = 3 A. V CE = 2V	100 80 三十		300	
f T	过渡频率	我 C = 0.1 A. V CE = 10V		100		兆赫

1. 脉冲持续时间= 300 ms, 占空比 ≤1.5%.

2.1 典型特征（曲线）

图2 反向偏置的安全操作区域图3.



直流电流增益

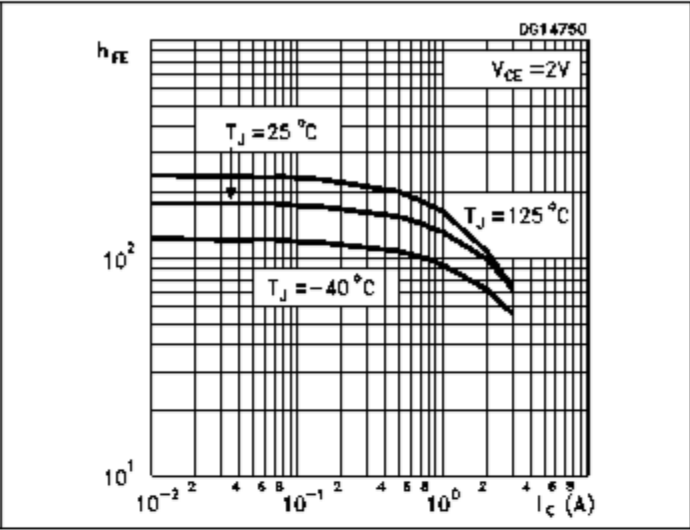
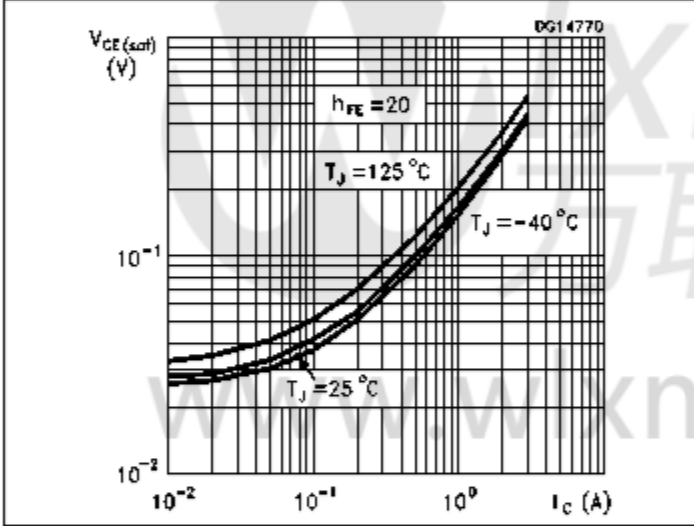
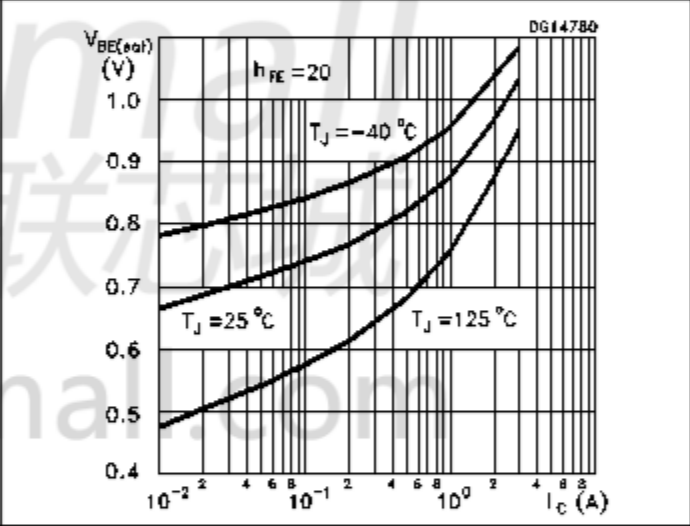


图4. 集电极发射极饱和电压图5.



基极发射极饱和电压



3 包装机械数据

为了达到环保要求，ST为这些设备提供ECOPACK®

包。这些封装具有无铅二级互连。类别

第二级互连标记在包装上和内盒标签上

符合JEDEC标准JESD97。与焊接有关的最大额定值

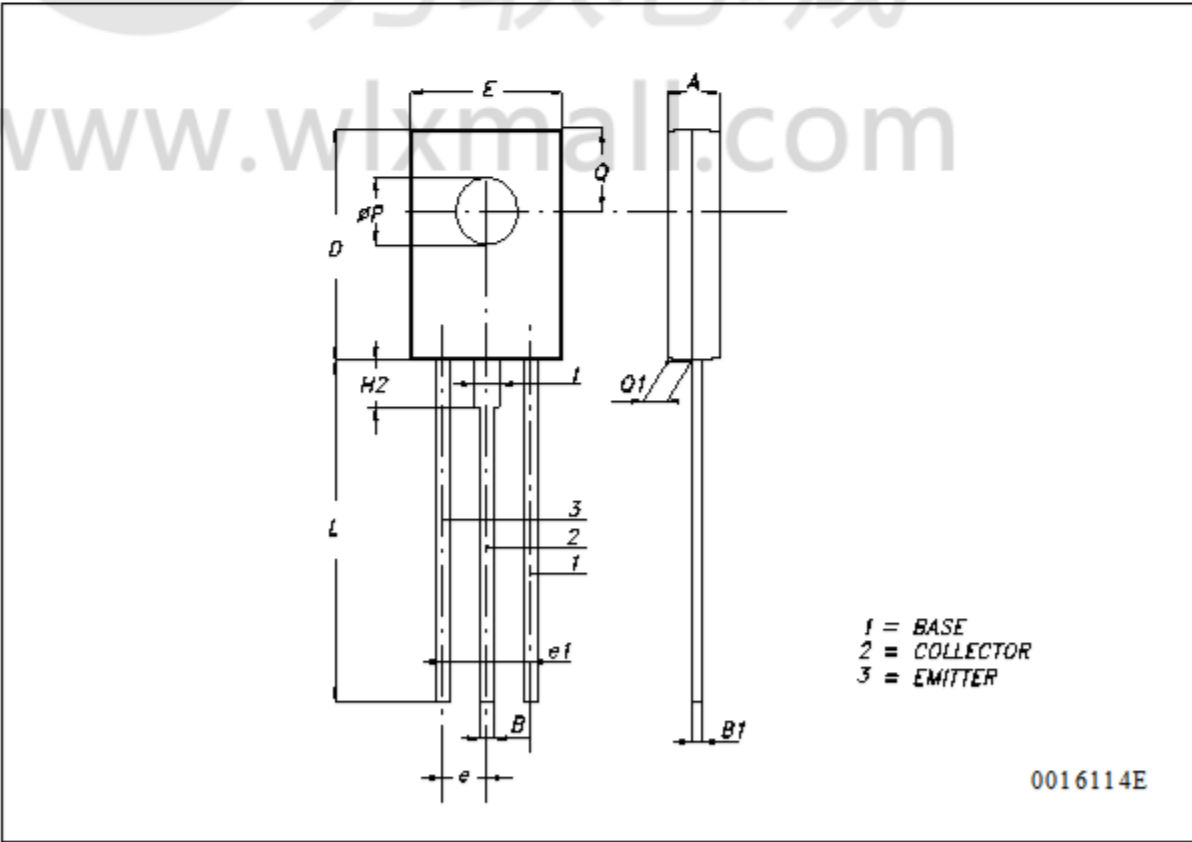
内盒标签上也标有条件。ECOPACK是ST的商标。

ECOPACK规范可在www.st.com上获得



SOT-32 (TO-126) 机械数据

暗淡.	毫米.		
	MIN.	TYP	MAX.
A 2 . 4			2.9
乙	0.64		0.88
B1	0.39		0.63
d	10.5		11.05
E 7 . 4			7.8
E	2.04	2.29	2.54
E1	4.07	4.58	5.08
L 1 5 . 3			16
P 2 . 9			3.2
Q3	0.8		
Q1	1		1.52
H2		2.15	
I1	0.2		



4 修订记录

表5 文档修订历史

日期	调整	变化
09月 - 2005年	2	最终数据表-新的模板
02 - 10月, 2007年	3	更新的机械数据



请仔细阅读：

本文档中的信息仅供ST产品使用。意法半导体公司及其附属公司（“ST”）保留所有权利。对本文档以及此处所述的产品和服务进行更改，更正，修改或改进的权利时间，恕不另行通知。

所有ST产品均按照ST的销售条款和条件进行销售。

购买者全权负责选择，选择和使用此处所述的ST产品和服务，ST承诺不会与本文所述ST产品和服务的选择，选择或使用相关的责任。

根据本文档，不得以任何禁止反言或以其他方式明示或暗示授予任何知识产权。如果这个的任何部分文件是指任何第三方产品或服务，不得被视为ST授权使用此类第三方产品的许可或服务或其中包含的任何知识产权，或作为保证涵盖以任何方式使用的保证。第三方产品或服务或其中包含的任何知识产权。

除非在ST的条款和销售条款中另有规定，ST否认不作任何明示或暗示有关使用和/或销售ST产品的担保，包括但不限于默示适销性，适用于特定用途的保证（及其在法律下的等同性任何司法管辖权），或侵犯任何专利，版权或其他知识产权。

除非经过授权的ST代表的书面明确批准，ST产品不是推荐，授权或担保用于军事，航空工程，空间，救生或维持生命应用，或在产品或系统中发生故障或故障可能导致人身伤害，死亡或严重的财产或环境损害。ST产品没有被指定为“汽车等级”只能在用户自行承担风险的情况下在汽车应用中使用。

ST产品的转售与本文件中陈述和/或技术特征不同的条款将立即失效。ST为ST产品或服务所授予的任何保证，不得以任何方式创建或延伸任何ST的责任。

ST和ST标志是ST在各个国家的商标或注册商标。

本文档中的信息取代并替换之前提供的所有信息。

ST标志是意法半导体的注册商标。所有其他名称是其各自所有者的财产。

©2007意法半导体 - 保留所有权利

意法半导体集团公司

澳大利亚 - 比利时 - 巴西 - 加拿大 - 中国 - 捷克 - 芬兰 - 法国 - 德国 - 香港 - 印度 - 以色列 - 意大利 - 日本 - 马来西亚 - 马耳他 - 摩洛哥 - 新加坡 - 西班牙 - 瑞典 - 瑞士 - 英国 - 美利坚合众国

www.st.com